

## Сведения об официальном оппоненте Гонике Михаиле Александровиче

Ученая степень, специальность: доктор технических наук, специальность 05.27.06. “Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники”

Ученое звание: с.н.с.

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью Центр материаловедения Фотон

Должность: Директор

Тел. +7 916 571 54 30

e-mail: michael.a.gonik@gmail.com

Почтовый адрес: 601655 Владимирская обл., Александровский р-н, г. Александров, ул. Ческа-Липа д.10

Список основных публикаций по теме диссертации в рецензируемых научных журналах за последние 5 лет:

1. Т.Р. Lyubimova, М.А. Gonik, А.О. Ivantsov, О. Khlybov, К. Zaidat, Т. Duffar, Influence of submerged heating on vertical Bridgman crystal growth of silicon under travelling magnetic field // J. Cryst. Growth. V. 531. 2020. 124340 (6 p.)
2. М.А. Gonik, F. Baltaretu, Problem of attaining constant impurity concentration over ingot height // Modern Electronic Materials. V. 4(2). 2018. p. 41–51.
3. М.А. Gonik, A. Cöll, A. Ch. Wagner. Ge distribution in Si<sub>0.9</sub>Ge<sub>0.1</sub> alloy ingot grown from thin melt layer // Modern Electronic Materials. V 2. 2016. p. 116–120.
4. М.А. Гоник, F. Baltaretu. Как обеспечить однородное распределение примеси вдоль слитка мультикристаллического кремния // ИВУЗ.МЭТ. 2018. Т. 21. № 2. С. 69-82.

5. S. Binetti, M.Gonik, A.Le Donne, A.Croell. Silicon sample grown under reduced melt convection // J. Cryst. Growth. 2015. V. 417. P. 9-15.
6. М.А. Гоник. Выращивание монокристаллов висмута и его сплава с сурьмой // Неорганические материалы. 2015. Т. 51, № 2. С. 148-156.
7. М.А. Гоник. Направленная кристаллизация мультикристаллического кремния в условиях ослабленной конвекции расплава и газообмена // Известия ВУЗов. Материалы электронной техники. 2015. Т. 18. № 2. С. 95-102.

Официальный оппонент

Директор ООО Центр материаловедения Фотон,

д. т. н.

Гоник М.А.

01.09.2015

